

RILSAMID®

AMNO P20 TLD

PA12-P, MHLR, 12-005

Rilsamid® AMNO P20 TLD树脂 是一种天然聚酰胺。该牌号经过增塑，设计用于注塑。

性能	干 / 已调节	单位	测试标准
流变性能			
熔体体积流动速度	44 / *	cm ³ /10min	ISO 1133
温度	235 / *	°C	-
	455 / *	°F	-
载荷	2.16 / *	kg	-
	4.76 / *	lb	-
机械性能			
拉伸模量	620 / 550	MPa	ISO 527-1/-2
	89900 / 79800	psi	
屈服应力	31 / 30	MPa	ISO 527-1/-2
	4500 / 4350	psi	
屈服伸长率	20 / 20	%	ISO 527-1/-2
名义断裂伸长率	>50 / >50	%	ISO 527-1/-2
简支梁冲击强度, +23°C	无断裂 / 无断裂	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁冲击强度, -30°C	无断裂 / 无断裂	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度, +23°C	9 / 14	kJ/m ²	ISO 179/1eA
	4.28 / 6.66	ftlb/in ²	
简支梁缺口冲击强度, -30°C	3 / 3	kJ/m ²	ISO 179/1eA
	1.43 / 1.43	ftlb/in ²	
热性能			
熔融温度, 10°C/min	173 / *	°C	ISO 11357-1/-3
热变形温度, 1.80 MPa	48 / *	°C	ISO 75-1/-2
	118 / *	°F	
热变形温度, 0.45 MPa	130 / *	°C	ISO 75-1/-2
	266 / *	°F	
维卡软化温度, 50°C/h 50N	134 / *	°C	ISO 306
	273 / *	°F	
线性热膨胀系数, 平行	120 / *	E-6/K	ISO 11359-1/-2
电性能			
相对介电常数, 100Hz	8 / -	-	IEC 60250
相对介电常数, 1MHz	4 / -	-	IEC 60250
介质损耗因子, 100Hz	2010 / -	E-4	IEC 60250

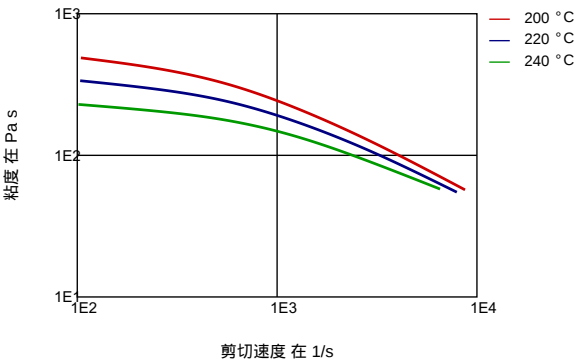
RILSAMID[®]

AMNO P20 TLD

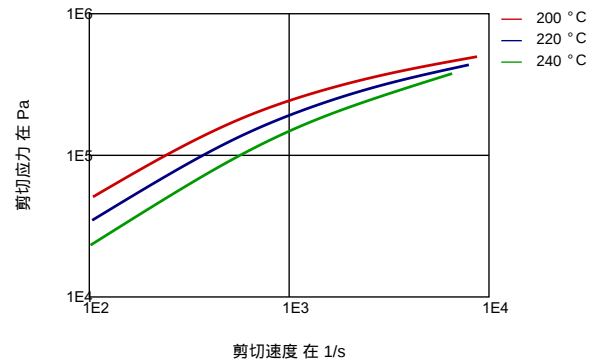
介质损耗因子, 1MHz	595 / -	E-4	IEC 60250
体积电阻率	- / 1E10	Ohm*m	IEC 60093
表面电阻率	* / 1E12	Ohm	IEC 60093
介电强度	- / 26	kV/mm	IEC 60243-1
	- / 660	kV/in	
相对耐漏电起痕指数, CTI	* / 600	-	IEC 60112
其它性能			
吸水性	1.4 / *	%	类似ISO 62
密度	1020 / 1020	kg/m ³	ISO 1183
	1.02 / 1.02	g/cm ³	

图表

粘度 - 剪切速度

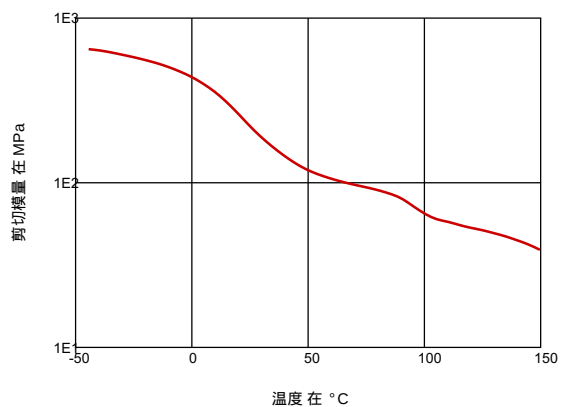


剪切应力 - 剪切速度

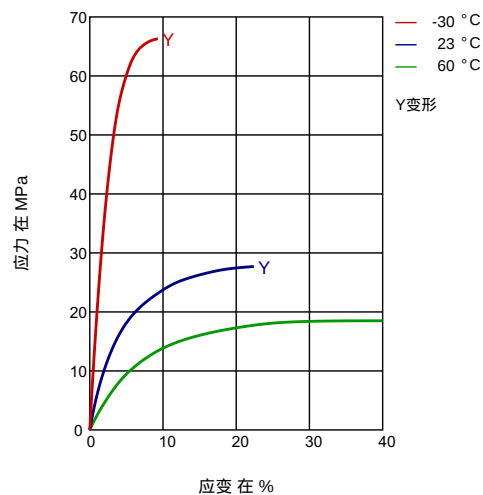


RILSAMID® AMNO P20 TLD

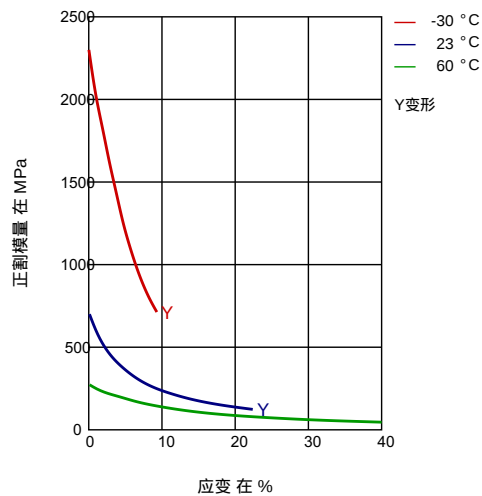
动态剪切模量 - 温度



应力 - 应变.



正割模量 - 应变.



Processing conditions, Injection:

- Typical melt temperature (Min / Recommended / Max) : 250°C / 270°C / 290°C.
- Mold temperature : 20 - 40°C
- Drying time and temperature (only necessary for bags opened for more than two hours) : 4-6 hours at 80 - 90°C.

RILSAMID®

AMNO P20 TLD

加工方法	
注塑	
供货形式	
粒料	
添加剂	
脱模助剂, 增塑剂	
特殊性能	
热稳定, 光稳定	
地区供应	
北美, 欧洲, 亚太, 中南美洲, 中东/非洲	